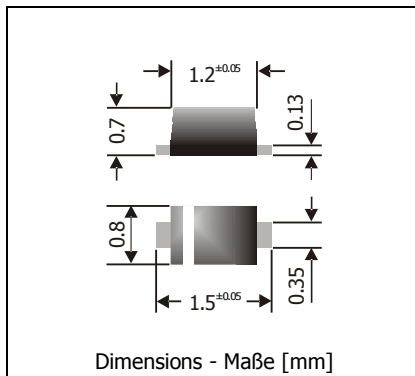


1N4148WT
Surface Mount Small Signal Diodes
Kleinsignal-Dioden für die Oberflächenmontage

Version 2012-05-03



Power dissipation – Verlustleistung	150 mW
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	75 V
Plastic case – Kunststoffgehäuse	~ SOD-523
Weight approx. – Gewicht ca.	0.01 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	

**Maximum ratings (T_A = 25°C)****Grenzwerte (T_A = 25°C)**

		1N4148WT	
Power dissipation – Verlustleistung	P _{tot}	150 mW ¹⁾	
Max. average forward current – Dauergrenzstrom (dc)	I _{FAV}	125 mA ¹⁾	
Repetitive peak forward current – Periodischer Spitzenstrom	I _{FRM}	250 mA ¹⁾	
Non repetitive peak forward surge current Stoßstrom-Grenzwert	t _p ≤ 1 µs t _p ≤ 100ms	I _{FSM} I _{FSM}	2 A ¹⁾ 1 A
Repetitive peak reverse voltage – Periodische Spitzensperrspannung	V _{RRM}	75 V	
Non repetitive peak reverse voltage – Stoßspitzensperrspannung	V _{RSM}	100 V ²⁾	
Junction temperature – Sperrschichttemperatur	T _j	-65...+150°C	
Storage temperature – Lagerungstemperatur	T _s	-65...+150°C	

Characteristics (T_j = 25°C)**Kennwerte (T_j = 25°C)**

Forward voltage Durchlass-Spannung	I _F = 1 mA I _F = 10 mA I _F = 50 mA I _F = 150 mA	V _F	< 0.715 V < 0.855 V < 1.000 V < 1.250V
Leakage current – Sperrstrom	V _R = 20 V V _R = 75 V	I _R I _R	< 25 nA < 1 µA
Leakage current – Sperrstrom, T _j = 125°C	V _R = 25 V V _R = 75 V	I _R I _R	< 30 µA < 50 µA
Max. junction capacitance – Max. Sperrschichtkapazität V _R = 0 V, f = 1 MHz		C _T	2 pF
Reverse recovery time – Sperrverzug I _F = 10 mA über/through I _R = 10 mA bis/to I _R = 1 mA		t _{rr}	< 4 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		R _{thA}	< 833 K/W ¹⁾

1 Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluss

2 Tested with pulses t_p = 300 µs, duty cycle ≤ 2% – Gemessen mit Impulsen t_p = 300 µs, Schaltverhältnis ≤ 2%

